

Spezifikationen	
Artikelnummer	1N5190
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	2543 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	-
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	400ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	B, Axial
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	2µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

sein:

sein:  1N5194UR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 70V 200MA DO213AA	 1N5188US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL	 1N5194 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 70V 200MA DO35	 1N5196 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 200MA DO35
 1N5189 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL	 1N5187US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL	 1N5188 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A AXIAL	 1N5189US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A D5B

Schlüsselwort

1N5190 Schlusswort	1N5190 Datenblatt	1N5190-Datenblätter	1N5190 PDF	Microsemi 1N5190
1N5190 Electronic	1N5190-Komponenten	1N5190-Verteiler	1N5190-Bild	1N5190-Teil
1N5190 Preis	1N5190 Hersteller	1N5190 Bild	1N5190 Aktie	1N5190 Inventar
1N5190 Neu	1N5190 Original	1N5190 garantiert	1N5190 RFQ	1N5190 Online bestellen